

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XT061N	文件编号	临时
	瞬态电压抑制（双向 TVS）二极管	版本号	18-A2-06
		页码	1/2

1 主要用途与主要特点

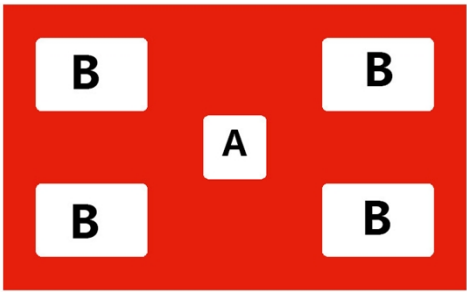
1.1 主要用途

用 W1XT061N 封装的成品管主要用于便携式电子产品中电源端的 ESD 保护。

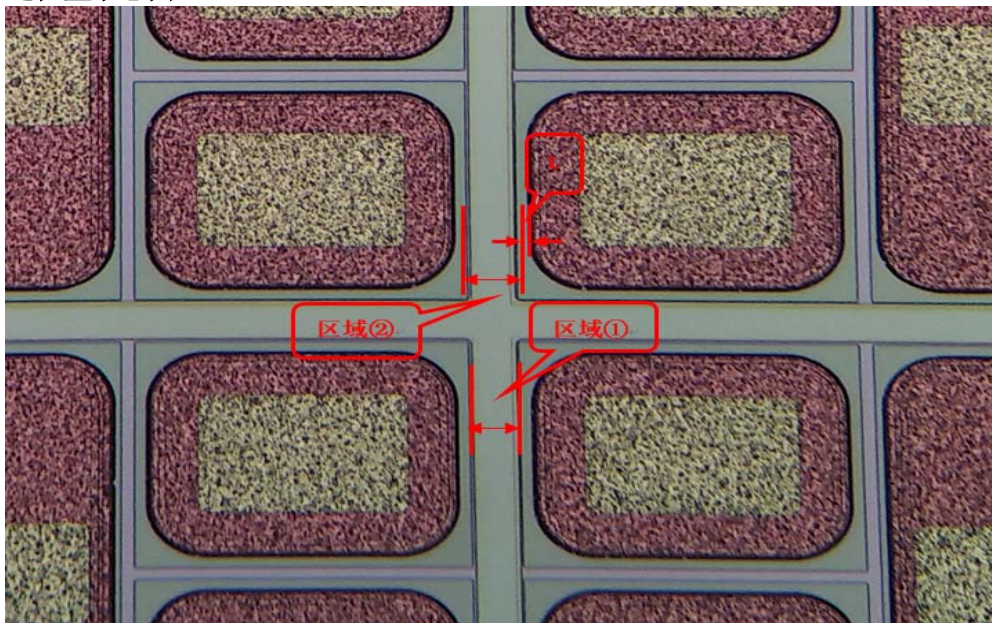
1.2 主要特点

- 低反向漏电
- 高静电防护能力
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.76×0.48		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	≤150		
	划片道*尺寸 (μm)	40		
	键合区面积 (μm ²)	96×96		
	正面电极	金属	铝	
		厚度 (um)	5.0± 1.0	
	背面电极	表层金属	银	金
		装片要求 (推荐)	低温共晶	共晶
	硅片直径 (mm)	φ 125		
	键合要求 (推荐)	铜丝; φ 28 μm; 每路 I/O 各 1 根		

* 划片道位置示意图:



备注：区域①为划片刀走刀区域，划片时应在两条参考线中间；区域②为划片道区域，宽度为 40μm；划片时划片道边缘到铝的距离 L 不小于 10μm 即判定为合格。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：Http://www.xs-elec.com

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XT061N	文件编号	临时
	瞬态电压抑制（双向 TVS）二极管	版本号	18-A2-06
		页码	2/2

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: SOT-363 推荐成品: CESDB3V3K5
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R = \pm 1\text{mA}$	3.8	4.8	5.8	V
反向电流	I_R	$V_R = \pm 3.3\text{V}$	—	—	1	μA
结电容	C_{tot}	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	—	22	40	pF
反向峰值电压	V_C	$I_{PP} = \pm 13\text{A}(8 \times 20\mu\text{s waveform})$	—	—	15	V

3.3 典型特性曲线

暂无

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532